

## ОТЗЫВ

научного руководителя на диссертационную работу Шарипова Аламшо Партоевича на тему: «Синтез и свойства антимонида и арсенида галлия в твердой и жидкой фазе», представленной на соискание ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 - «Материаловедение (в электротехнике)»

Диссертационная работа Шарипова Аламшо Партоевича выполнена на кафедры общей и теоретической физики, методики преподавания физики и технологии материалов Култубского государственного университета имени Абуабдуллохи Рудаки.

Актуальность темы объясняется перспективными полупроводниковыми соединениями, к которым можно отнести двойные и тройные халькогениды галлия соединения группы  $A^{III}B^V$  и в частности твердые растворы на их основе. Соискатель на основе литературного обзора по соединениям  $A^{III}B^V$  справедливо приходит к выводу, что полупроводники этих типов обладают эффективными сочетаниями электрофизических и термоэлектрических свойств, которые могут быть исследованы как на поликристаллических, так и на монокристаллических образцах и следовательно выращивание монокристаллов для некоторых халькогенидов галлия, методом газотранспортной реакции, требует специальной аппаратуры и методики проведения технологических процессов.

В ходе работы над диссертацией Шариповым А.П. достигнута поставленная научная цель, которая заключается в экспериментальном исследование электрофизических и физико-химических свойств антимонида и арсенида галлия, а также легированных образцов в широком интервале температур и усовершенствования технологических процессов синтеза и получения поли- и монокристаллов этих соединений. К наиболее значимым результатам исследования принадлежат основные положения и содержательные выводы диссертации.

Научная новизна работы заключается в проведении комплексных исследований по разработке технологии получения поли- и монокристаллов полупроводниковых соединений в тройной системе Ga-As-Sb, как чистых, так и процессы легированных, а также исследования физико-химических, термоэлектрических и термодинамических свойств в широком интервале температур

Разработаны Шариповым А.П. математические модели, на основе которых разработана новая разновидность метода химических транспортных реакций, позволившая получить монокристаллы соединений типа  $A^{III}B^V$ , а также и определена температурная зависимость теплоемкости, определены отдельные ее составляющие части и установлены пределы экспоненциально-го закона температурной зависимости теплоемкости в соединениях  $A^{III}B^V$ . По данным теплоемкости рассчитана температурная зависимость термодинамических функций этих соединений. Адекватность данного способа подтверждается тремя Малыми патентами Республики Таджикистана на изобретение.

Таким образом, диссертационная работа А.П. Шарипова вносит существенный вклад в исследование температурных зависимостей физико-химических, электрофизических свойств соединений  $A^{III}B^V$  сделано заключение о том, что не наблюдаются радикальные изменения в характере химической связи и структуре ближнего порядка при плавлении и дальнейшем нагреве расплавов данных соединений.

Результаты и основные положения диссертационного исследования были представлены и получили положительную оценку на международных и республиканских конференциях.

Работа носит самостоятельный характер, что подтверждается наличием выводов, корректным цитированием литературных источников, а также опубликованными статьями автора по теме исследования.

**Вклад соискателя** заключается в разработке и реализации плана исследований, в постановке и решении задач исследования, выполненных в соавторстве, получении, обработке и анализе большинства экспериментальных данных и результатов экспериментов, а также в формулировке основных положений и выводов диссертации.

Соискатель Шарипов А.П. своим усердием работать скрупулённо показал как теоретическую, так и на экспериментальную сторону исследовательской работы. Он дорос до такого уровня, что самостоятельно решил отдельные задачи по направлению своей диссертационной работы.

Таким образом, диссертационная работа Шарипова Аламшо Партоевича на тему: «Синтез и свойства антимонида и арсенида галлия в твердой и жидкой фазе» является самостоятельным, законченным исследованием, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК РТ к кандидатским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения ученой степени кандидата технических наук по специальности 05.02.01 - «Материаловедение (в электротехнике)».

### **Научный руководитель:**

доктор химических наук (02.00.04 – физическая химия), профессор, заслуженный деятель науки РТ, деятель науки и техники РТ, академик инженерной академии РТ, академик филиала международной инженерной академии (РФ), академик инженерной академии Исламских государств

Каримов  
Самаритдин Каримович

Подпись д.х.н., проф. Каримова С.Р. заверяю:  
Начальник ОКиСР КГУ им. А. Рудаки



*Амирев Ф.*